

Problema 34

Diséñese un amplificador JFET drenaje común como el mostrado en la figura 3, con:
 $RL=10K$, $RiA=200K$, $VDD=12V$.

Para $VGS=-1V$ e $IDQ=1mA$, $gm=4mS$.

Calcular la ganancia de corriente y ganancia de tensión del circuito.

Sabiendo que para $ID=1mA$ y $gm=4mS$ obtenemos $\Rightarrow IDSS=9mA$ y $Vp=-1,5V$

Fijo $VDSQ=7V$, $IDQ=6mA$, $VGS=-0,28V$

$$VRs = VDD - VDSQ = 5V$$

$$Rs = 820\Omega$$

$$VGG = VRs + VGS = 4,64V$$

$$RG = RiA = 200K$$

$$R1 \cdot VGG = VDD \cdot RG$$

$$R1 = 517,2K \cong 560K$$

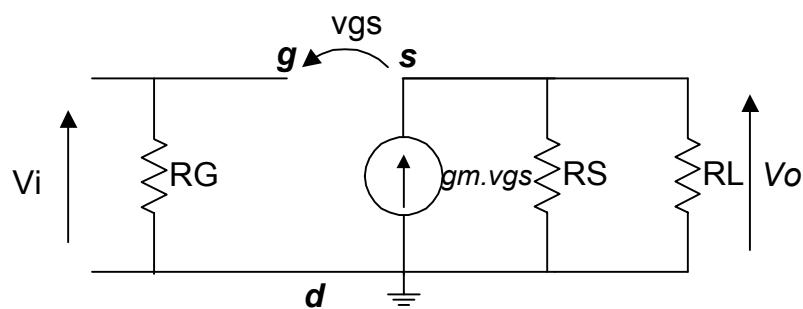
$$R2 = 326K \cong 390K$$

$$RG = 230K$$

$$Rd = RS \| RL = 757,8\Omega$$

$$gm = 9,7mS$$

Cálculo de las ganancias:



$$Ai_A = -\frac{RG}{RL} \cdot \frac{gm \cdot Rd}{1 + gm \cdot Rd} = -20,2$$

$$AV = \frac{gm \cdot Rd}{1 + gm \cdot Rd} = 0,88$$

Problema 35

Diseñar un circuito amplificador para las siguientes condiciones:

$$RiA = 100K, RL = 10K, VDD = 20V.$$

El circuito corresponde a la figura 5. El punto Q se selecciona en:

$$IDQ = 3,33mA, VDSQ = 10V, VGSQ = -1V, gm = 2mS.$$

Análisis de continua:

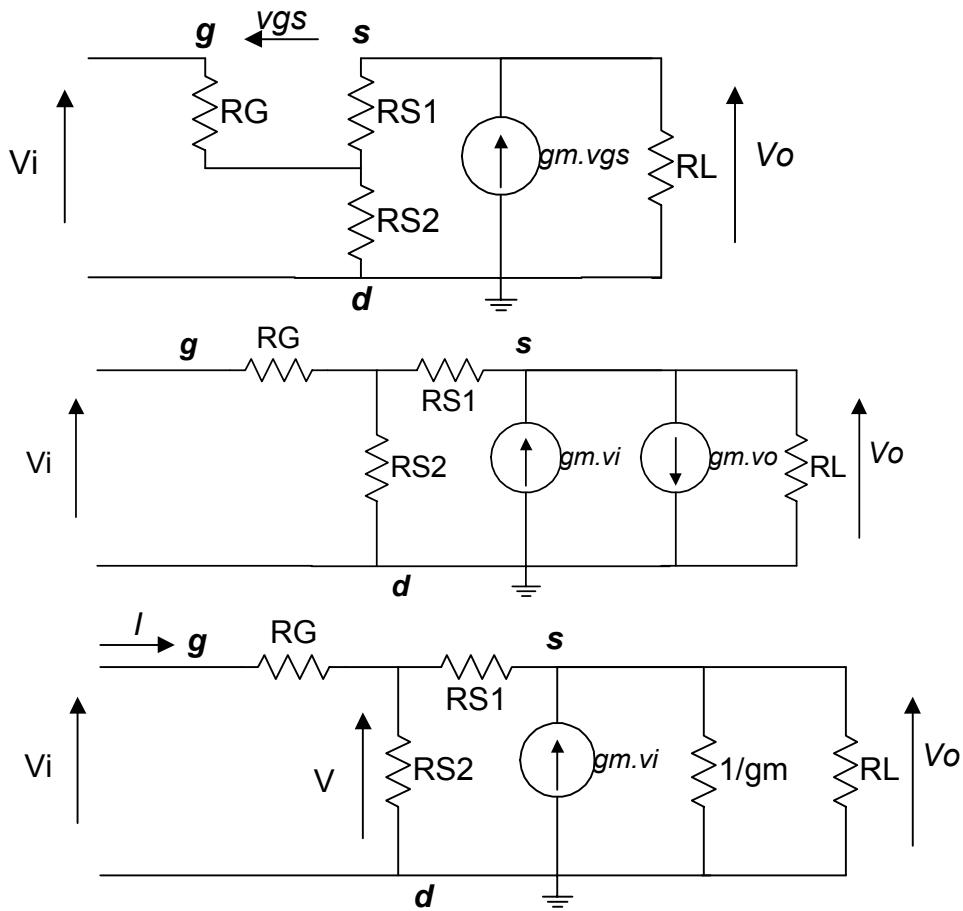
$$VGSQ = -IDQ \cdot RS1 = -3,33mA \cdot RS1$$

$$RS1 = 300\Omega \approx 330\Omega$$

$$VDD = VDS + ID \cdot (RS1 + RS2)$$

$$RS2 = \frac{20V - 10V}{3,33mA} - 330\Omega = 2673\Omega \approx 2,7K$$

Análisis de señal:



$$RiA = \frac{Vi}{I} \quad I = \frac{Vi - V}{RG}$$

$$V = Vo \cdot \frac{RS2}{RS1 + RS2}$$

$$AV = \frac{\frac{gm}{1}}{\frac{gm}{RS1 + RS2} + \frac{1}{RL}} = 0,82$$

$$Vo = AV \cdot Vi$$

$$I = \frac{Vi - Vo \cdot \frac{RS2}{RS1 + RS2}}{RG} = \frac{Vi - AV \cdot Vi \cdot \frac{RS2}{RS1 + RS2}}{RG} = Vi \cdot \left(1 - AV \cdot \frac{\frac{RS2}{RS1 + RS2}}{RG} \right)$$

$$RiA = \frac{Vi}{I} = \frac{RG}{1 - AV \cdot \frac{RS2}{RS1 + RS2}}$$

$$RG = RiA \cdot \left(1 - AV \cdot \frac{RS2}{RS1 + RS2} \right) \cong 27K$$

Problema 36

Determinar el valor de los resistores y la ganancia de corriente para un seguidor de fuente de refuerzo (figura 5) que requiere:

$R_{iA}=200K$, $RL=20K$ y $VDD=10V$.

Las características del transistor son $V_p=-1,75V$ e $IDSS=20mA$.

Análisis estático:

$$IDQ = 0,6 \cdot IDSS = 12mA$$

$$VGS = \left(\sqrt{\frac{IDQ}{IDSS}} - 1 \right) \cdot (-Vp) = -0,394V$$

$$|VGS| = IDQ \cdot RS1 \Rightarrow RS1 = 33\Omega$$

$$gm = \frac{2 \cdot IDSS}{Vp} \cdot \sqrt{\frac{IDQ}{IDSS}} = 18mS$$

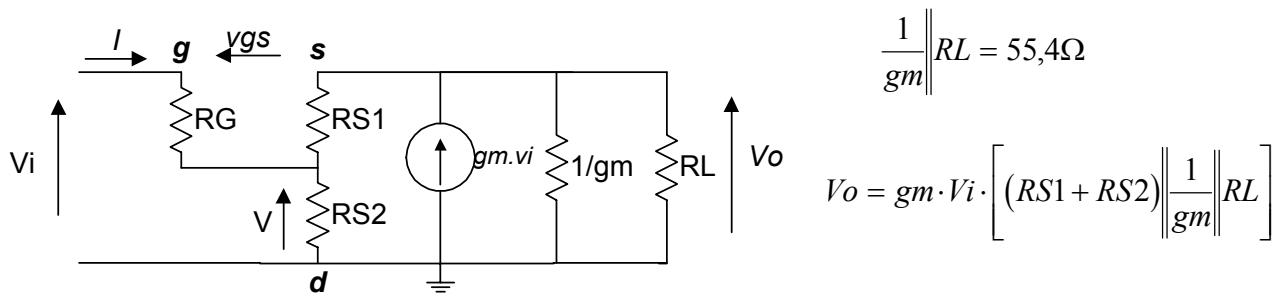
$$VDSQ \geq |VGS - Vp| = 1,356V \Rightarrow VDSQ = 6V \quad \text{elegida del gráfico de las características de salida}$$

$$VDSQ = VDD - IDQ(RS1 + RS2) \Rightarrow RS1 + RS2 = 333,3\Omega$$

$$RS2 = 270\Omega$$

$$VDSQ = 6,36V$$

Análisis dinámico:



$$\frac{1}{gm} \parallel RL = 55,4\Omega$$

$$Vo = gm \cdot Vi \cdot \left[(RS1 + RS2) \parallel \frac{1}{gm} \parallel RL \right]$$

$$AV = \frac{Vo}{Vi} = gm \left[(RS1 + RS2) \parallel \frac{1}{gm} \parallel RL \right] = 0,84$$

como $RG >> RS2$

$$V = V_o \cdot \frac{RS2}{RS1 + RS2}$$

$$I = \frac{Vi - V}{RG} = \frac{Vi - V_o \cdot \frac{RS2}{RS1 + RS2}}{RG} = \frac{Vi}{RG} \cdot \left(1 - AV \cdot \frac{RS2}{RS1 + RS2} \right)$$

$$RiA = \frac{Vi}{I} = \frac{Vi \cdot RG}{Vi \cdot \left(1 - AV \cdot \frac{RS2}{RS1 + RS2} \right)} = \frac{RG}{1 - AV \cdot \frac{RS2}{RS1 + RS2}}$$

$$RG = RiA \cdot \left(1 - AV \cdot \frac{RS2}{RS1 + RS2} \right) = 50,3K \cong 56K$$

$$Ai = \frac{IL}{I} \quad IL = -\frac{V_o}{RL} = -\frac{gm \cdot Vi}{RL} \cdot \left[(RS1 + RS2) \left| \frac{1}{gm} \right| RL \right]$$

$$Ai = \frac{IL}{I} = \frac{-gm \cdot Vi \cdot RG}{RL \cdot Vi \cdot \left(1 - AV \cdot \frac{RS2}{RS1 + RS2} \right)} \cdot \left[(RS1 + RS2) \left| \frac{1}{gm} \right| RL \right] = -AV \cdot \frac{RiA}{RL} \cong -9,3$$

Problema 37

Diseñar un amplificador MOSFET fuente común de canal N utilizando un transistor 3N128 para una carga de 10K con una ganancia de tensión $AV=-10$. Utilizar la configuración de la figura 1. Seleccionar el punto Q utilizando las curvas características mostradas en las especificaciones. La RiA debe ser mayor a 10K. Rs desacoplada con capacitor.

$$AV = gm \cdot Rd = -10$$

$$RiA = RG = R1 \parallel R2$$

$$IDSS = 15mA$$

$$V_p = -3V$$

$$\text{Adopto} \quad IDQ = 12mA \quad \Rightarrow \quad gm = 9mS \quad VGS = -0,32V$$

$$VDSQ = VDD - IDQ \cdot (RD + Rs)$$

Adopto $VDSQ = 5V$

Para hallar RD:

$$gm \cdot Rd = 10 \quad \Rightarrow \quad Rd = 1111\Omega$$

$$RD = \left(\frac{1}{Rd} - \frac{1}{RL} \right)^{-1} = 1,2K$$

Para hallar Rs:

$$RS = \frac{VDD - VDSQ - IDQ \cdot RD}{IDQ} = 390\Omega \quad (VDD = 24V)$$

$$VGG = IDQ \cdot RS + VGS = 4,36V$$

Para calcular RiA:

$$RiA = RG = R1 \parallel R2$$

supongamos $RiA = 15K$, entonces:

$$R1 \cdot VGG = RG \cdot VDD \quad \Rightarrow \quad R1 = 82K$$

$$R2 = \left(\frac{1}{RG} - \frac{1}{RL} \right)^{-1} \quad \Rightarrow \quad R2 = 18K$$